

# SANYO

# 三洋半導体ニュース

No. 5182

71495

新

## 2SA1967 — NPN三重拡散プレーナ形シリコントランジスタ 高電圧増幅, 高電圧スイッチング用

- 特長
- ・高耐圧である ( $V_{CEO\ min} = -900V$ )。
  - ・Cobが小さい ( $Cob\ typ = 2.2pF$ )。
  - ・高信頼性である (HVPプロセス採用)。

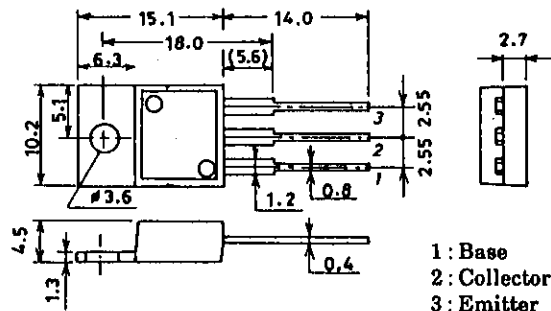
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings /  $T_a = 25^\circ C$

			unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CB0}$	-900	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CE0}$	-900	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EB0}$	-7	V
コレクタ電流	$I_C$	-10	mA
コレクタ電流 (パルス)	$I_{CP}$	-30	mA
コレクタ損失	$P_C$	1.75	W
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ C$
保存周囲温度	$T_{stg}$	-55 ~ +150	$^\circ C$

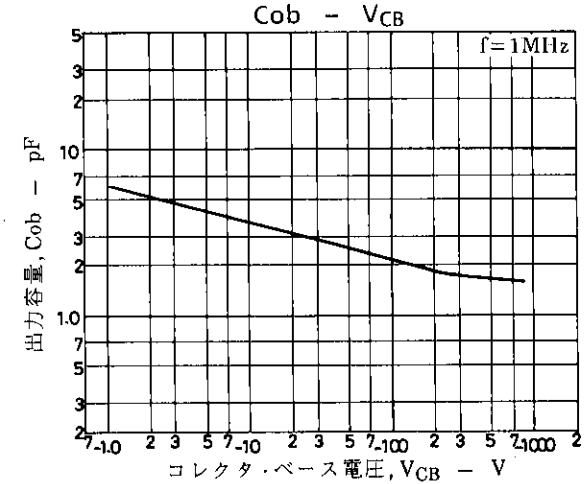
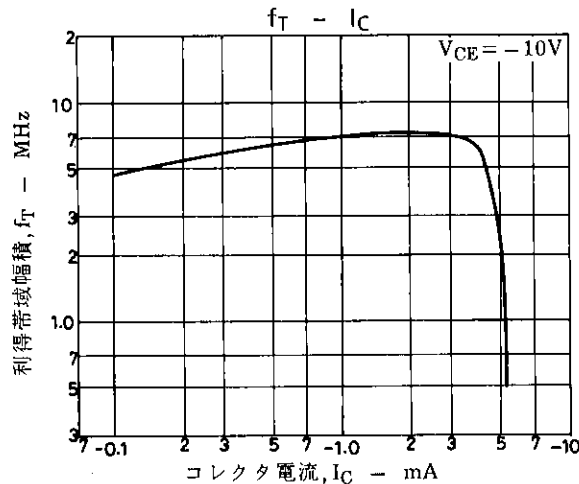
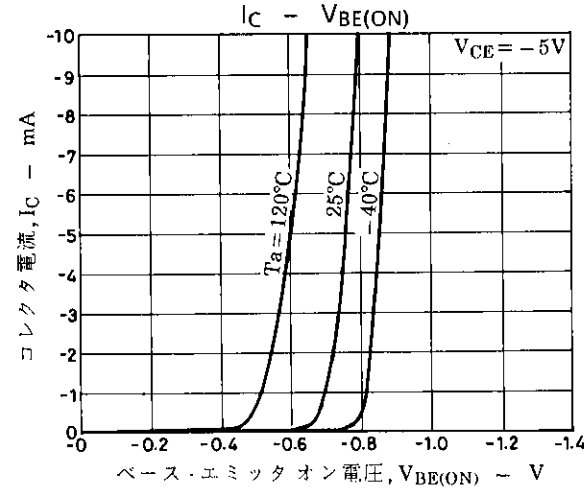
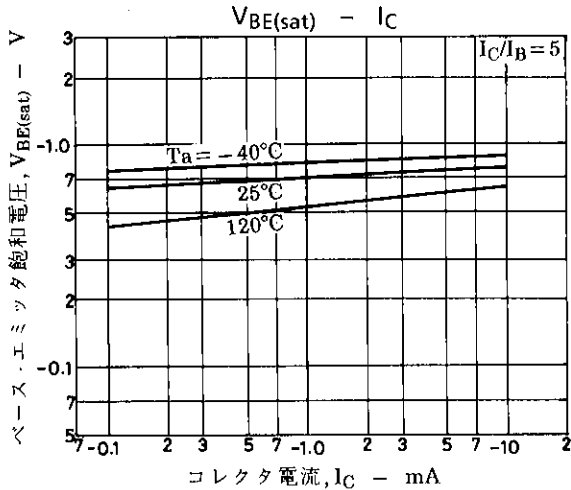
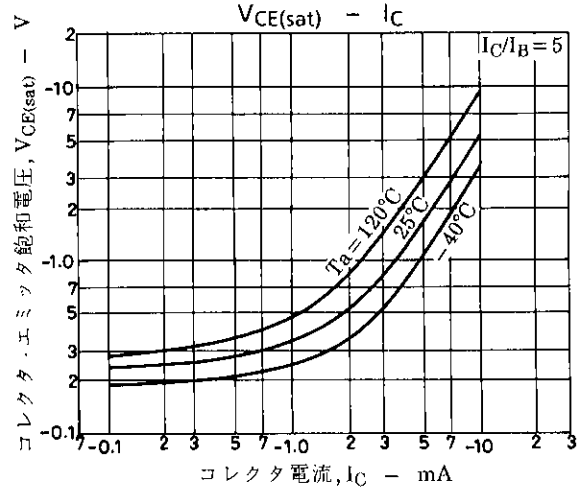
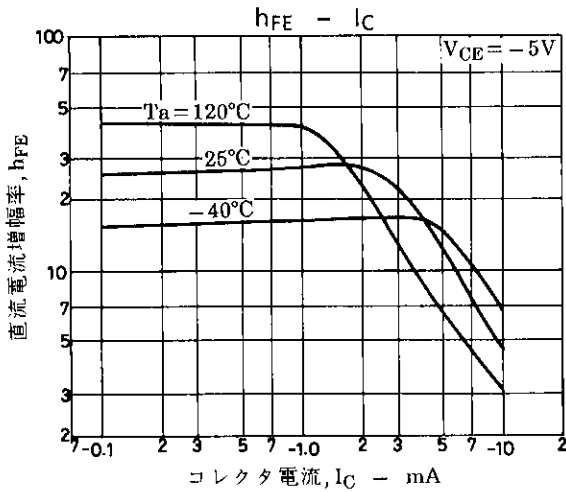
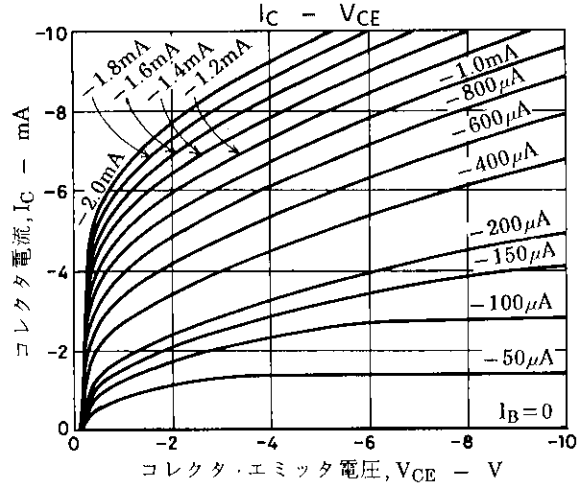
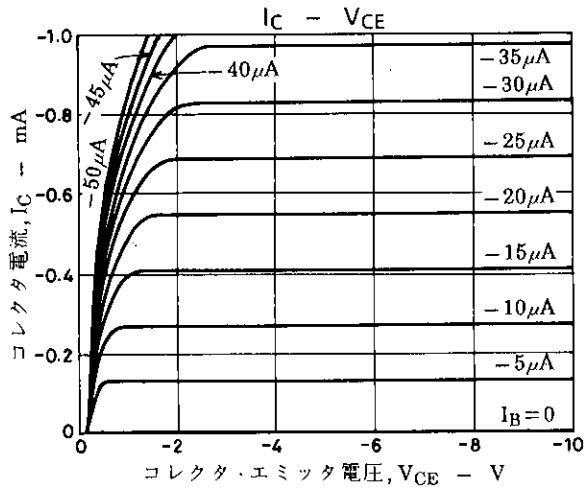
電気的特性 Electrical Characteristics /  $T_a = 25^\circ C$

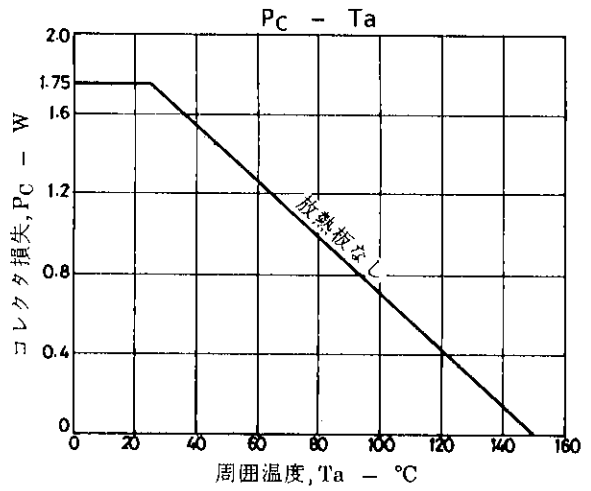
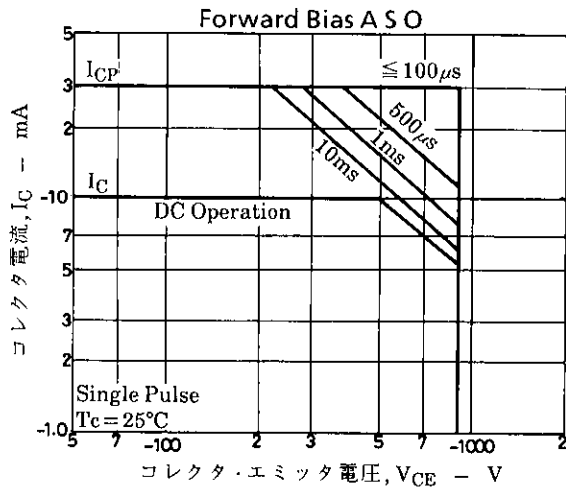
			min	typ	max	unit
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = -900V, I_E = 0$			-1	$\mu A$
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$			-1	$\mu A$
直流電流増幅率	$h_{FE}$	$V_{CE} = -5V, I_C = -1mA$	20		50	
利得帯域幅積	$f_T$	$V_{CE} = -10V, I_C = -1mA$		6		MHz
出力容量	Cob	$V_{CB} = -100V, f = 1MHz$		2.2		pF
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -500\mu A, I_B = -100\mu A$			-1	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -500\mu A, I_B = -100\mu A$			-1.5	V
コレクタ・ベース降伏電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_C = -100\mu A, I_E = 0$	-900			V
エミッタ・コレクタ降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -1mA, R_{BE} = \infty$	-900			V
エミッタ・ベース降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = -100\mu A, I_C = 0$	-7			V

外形図 2010C  
(unit: mm)



JEDEC: TO220AB  
EIAJ : SC46





- この資料の情報(掲載回路および回路定数を含む)は一例を示すもので、製品セットとしての設計を保証するものではありません。また、この資料は正確かつ信頼すべきものであると確信しておりますが、その使用にあたって第三者の工業所有権その他の権利の実施に対する保証を行うものではありません。
- 本書記載製品が、外国為替および外国貿易管理法に定める戦略物資(役務を含む)に該当する場合、輸出する際に同法に基づく輸出許可が必要です。
- 本書記載の製品は、生命維持装置等、人命にかかわるような、極めて高度の信頼性を要する用途に対応する仕様にはなっていません。そのような場合には、あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下さい。
- 本書に記載された内容は、製品改善および技術改良等により将来予告なしに変更することがあります。したがって、ご使用の際には、「納入仕様書」でご確認下さい。